

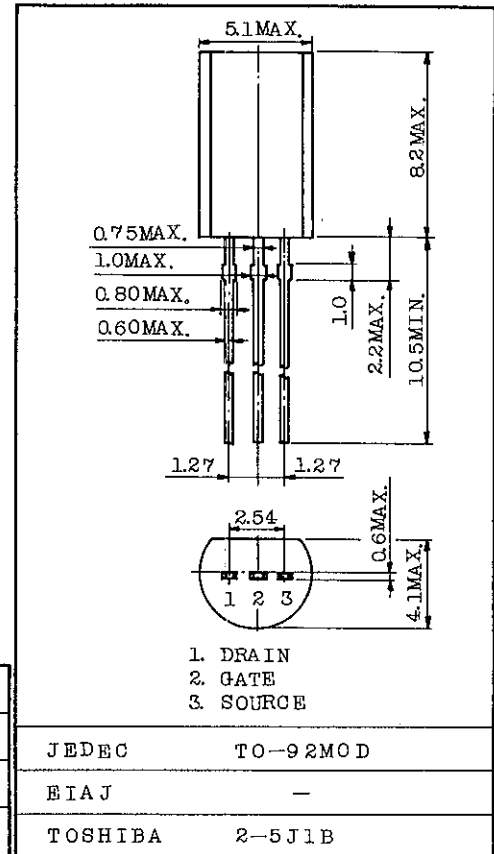
2SJ72

シリコンPチャンネル接合形トランジスタ SILICON P-CHANNEL JUNCTION TRANSISTOR

廃止品

- 低周波低雑音増幅用
- Low Noise Audio Amplifier Applications.
- ・ イコライザアンプ, MCヘッドアンプの初段に適します。
- ・ High g_m のため高利得が得られます。
: $g_m=40\text{m}\Omega$ (Typ.) ($V_{DS}=-10\text{V}, V_{GS}=0, I_{DSS}=-5\text{mA}$)
- ・ 超低雑音です。: $NF=1.0\text{dB}$ (Typ.)
($V_{DS}=-10\text{V}, I_D=-5\text{mA}, f=1\text{kHz}, R_g=100\Omega$)
- ・ 高入力インピーダンスです。: $I_{GSS}=1\text{nA}$ (Max.)
($V_{DG}=-25\text{V}$)
- ・ 許容損失が大きい。: $P_D=600\text{mW}$
- ・ Complementary to 2SK147

Unit in mm



最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

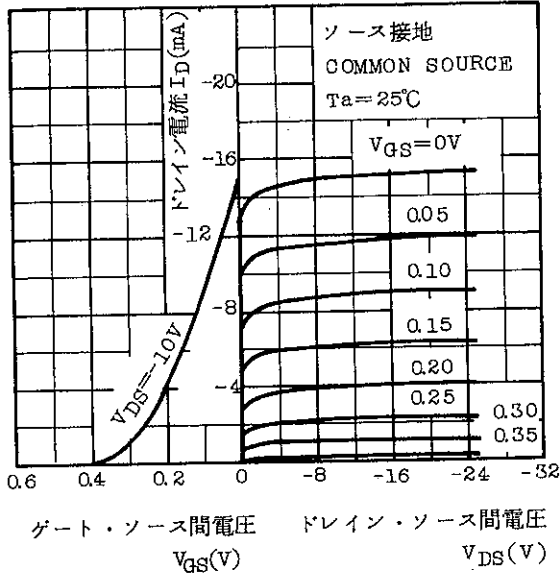
CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
ゲート・ドレイン間電圧	V_{GDS}	25	V
ゲート電流	I_G	-10	mA
許容損失	P_D	600	mW
接合温度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~125	$^\circ\text{C}$

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

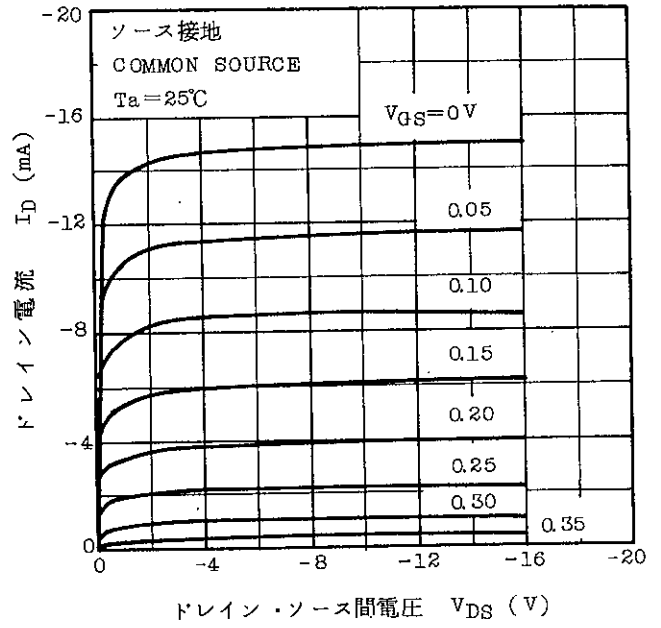
CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	$V_{GS}=25\text{V}, V_{DS}=0$	-	-	10	nA
ゲート・ドレイン間降伏電圧	$V_{(BR)GDS}$	$V_{DS}=0, I_G=100\mu\text{A}$	25	-	-	V
ドレイン電流	I_{DSS} (Note)	$V_{DS}=-10\text{V}, V_{GS}=0$	-50	-	-30	mA
ピンチオフ電圧	V_P	$V_{DS}=-10\text{V}, I_D=-0.1\mu\text{A}$	0.3	-	2.0	V
相互コンダクタンス	g_m	$V_{DS}=-10\text{V}, V_{GS}=0,$ $f=1\text{kHz}$ (TYP: $I_{DSS}=-5\text{mA}$)	30	40	-	$\text{m}\Omega$
入力容量	C_{iss}	$V_{DS}=-10\text{V}, V_{GS}=0, f=1\text{MHz}$	-	185	-	pF
帰還容量	C_{rss}	$V_{DG}=-10\text{V}, I_D=0, f=1\text{MHz}$	-	55	-	pF
雑音指数	NF(1)	$V_{DS}=-10\text{V}, R_g=100\Omega$ $I_D=-5\text{mA}, f=100\text{Hz}$	-	5	10	dB
	NF(2)	$V_{DS}=-10\text{V}, R_g=100\Omega$ $I_D=-5\text{mA}, f=1\text{kHz}$	-	1	2	

Note: I_{DSS} 区分/ I_{DSS} classification GR: -50~-100, BL: -80~-160, V: -14.0~-30.0

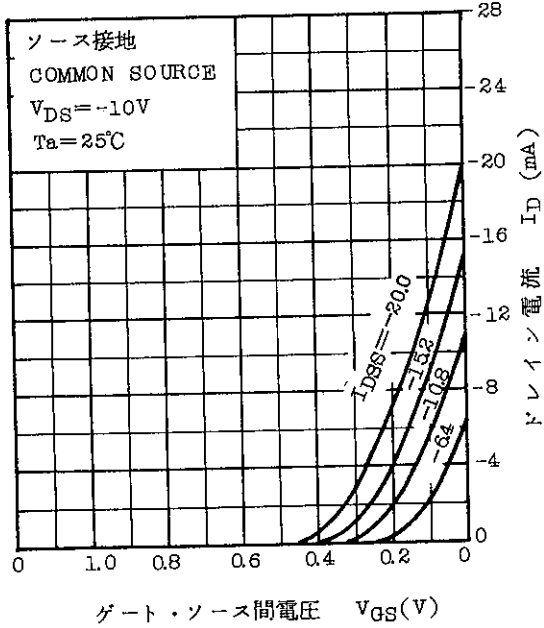
STATIC CHARACTERISTICS



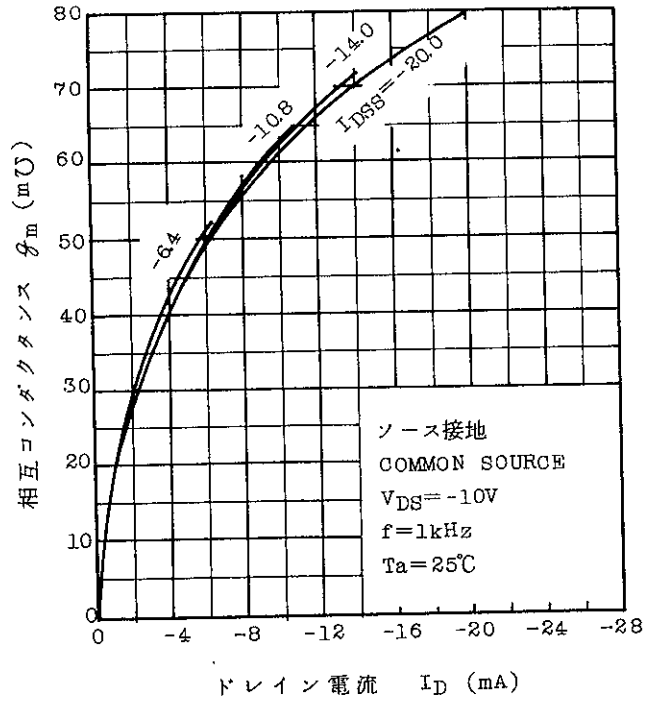
I_D - V_{DS} (LOW VOLTAGE REGION)



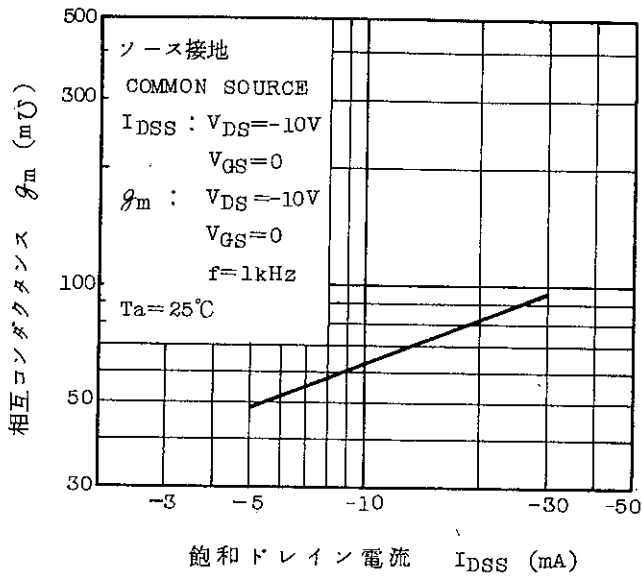
I_D - V_{GS}



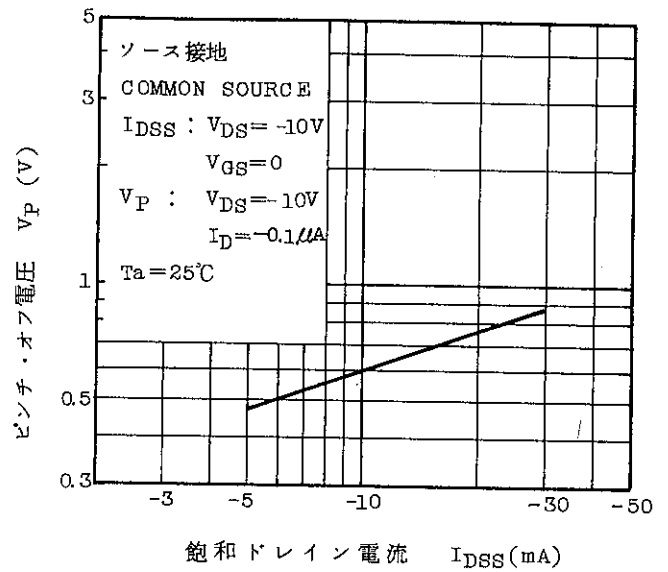
g_m - I_D



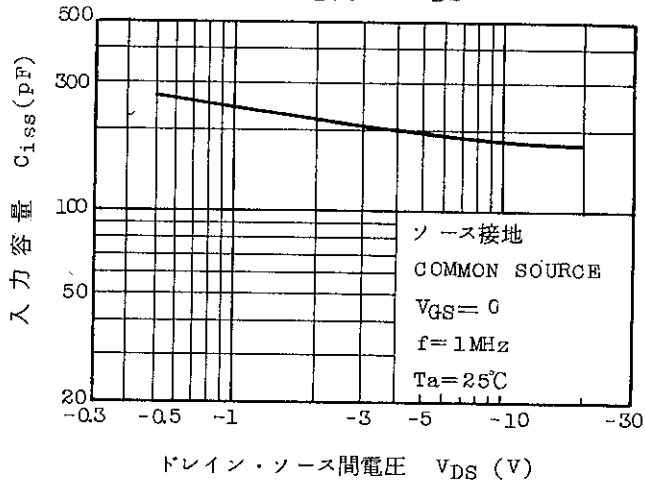
$g_m - I_{DSS}$



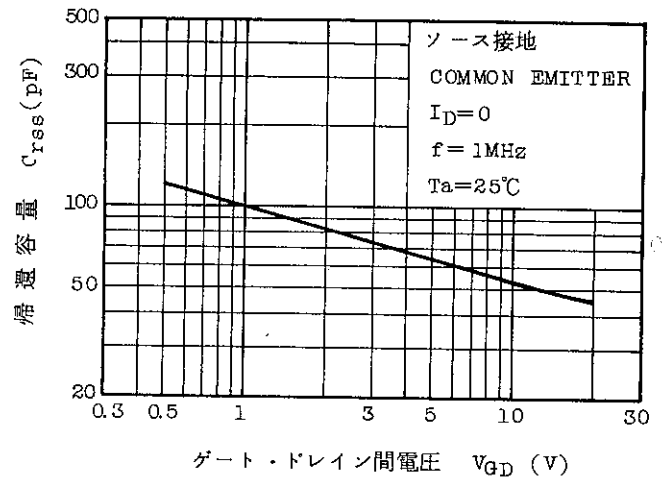
$V_p - I_{DSS}$



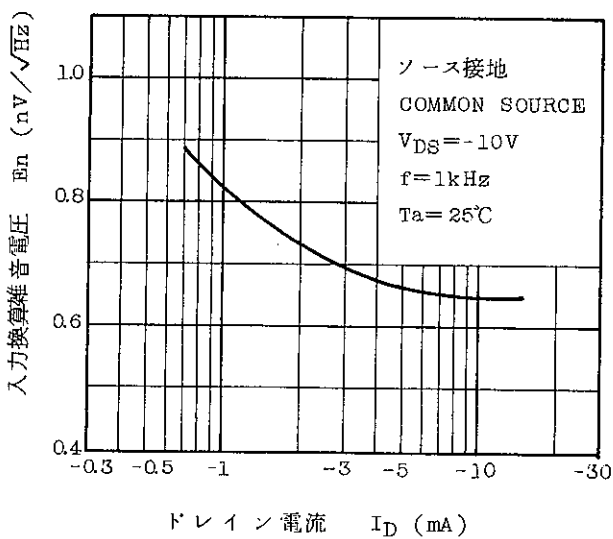
$C_{iss} - V_{DS}$



$C_{rss} - V_{GD}$



$E_n - I_D$



$I_{GX} - V_{DS}$

